



10mm Ge 大光敏面探测器（BNC 接口输出）



产品总览

锗光电二极管通常用于测量近红外范围内的光功率，尤其是在成本敏感型应用或需要大面积探测器的应用中。然而，与类似尺寸的 InGaAs 探测器相比，锗探测器的分流电阻较低，暗电流较高，导致整体噪声水平较高。因此，锗探测器非常适合检测信号远高于本底噪声的应用。筱晓光子提供“HS”系列锗光电二极管，其分流电阻高于典型值，可提高性能。

产品特点

- 芯片直径从 1 毫米到 25 毫米
- 光谱响应从 800 nm 到 1700 nm
- 多种窗口和镜头选项
- 可用的光学滤波器（中性密度、带通等）
- 热电冷却选项
- 多种封装类型：TO 封装、BNC 选项、陶瓷基座上的芯片等

产品应用

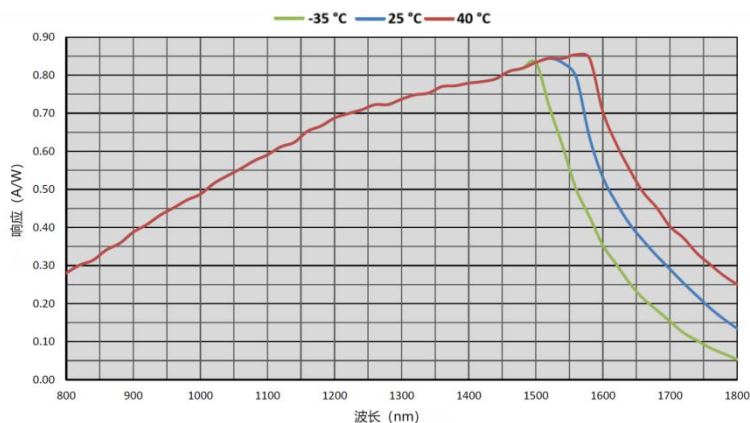
- 光功率测量
- 光谱学
- 光学测试
- 医疗诊断
- 光纤接收器

参数

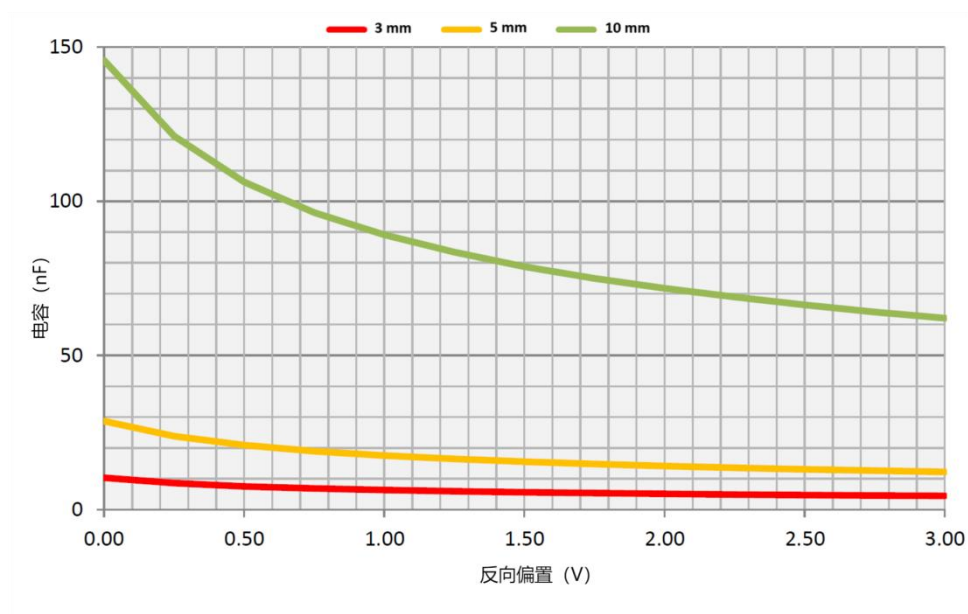
10X10mm 锗光电二极管性能规格				
型号	GB10M-XX	GE-10X10-BNC	GV10M-XX	
光电特性 @ 23 °C ± 2 °C				单位
R^{SHUNT} @ 10mV (最小/典型)	联系我们	2/3.5	联系我们	kΩ
I^{DARK} (最大)		50		μA
电容 (最大)		90000		pF
$V^{REVERSE}$		0.5		V
噪声等效功率 (典型)		6		pW/Hz ^{1/2}
最大反向电压		1		V

锗光电二极管		
光电特性 @ 23 °C ± 2 °C		
光谱响应范围	800-1700	nm
响应度@850 nm (典型值)	0.30	A/W
响应度@1300 nm (典型值)	0.75	A/W
响应度@1550 nm (典型值)	0.85	A/W
线性度	10	dBm
存储温度	-40 to 125	°C
工作温度	-40 to 85	°C
最大额定值 @ 23 °C ± 2 °C		
反向电流	20	mA
正向电流	10	mA

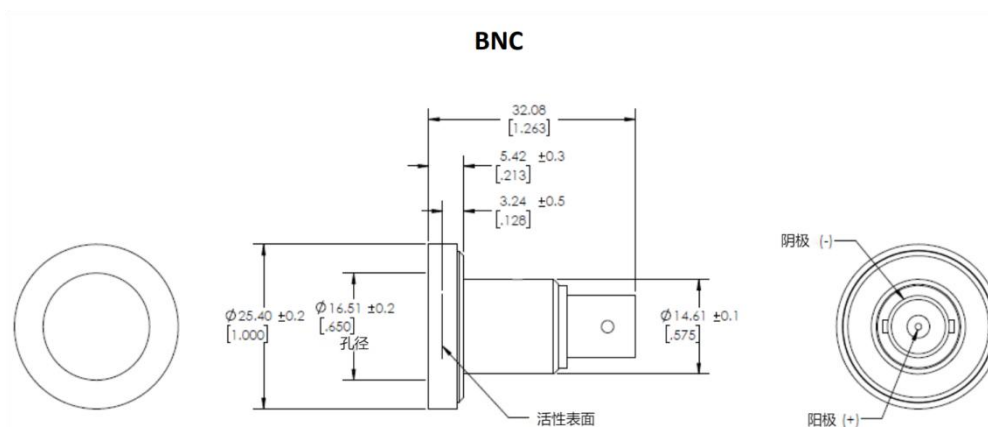
不同温度波长响应曲线:



电容偏置电压曲线：



封装尺寸：



订购信息：

型号：GE-10X10-BNC